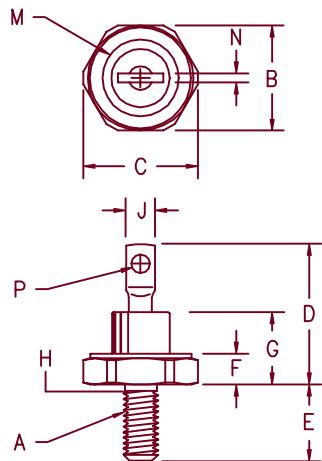


Military Silicon Power Rectifier

1N1202A–1N1206A, 1N3671A–1N3673A



Notes:

1. 10–32 UNF3A
2. Full threads within 2 1/2 threads
3. Standard Polarity: Stud is Cathode
Reverse Polarity: Stud is Anode

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	---	---	---	---	1
B	.424	.437	10.77	11.10	
C	---	.505	---	12.83	
D	---	.800	---	20.32	
E	.422	.453	10.72	11.51	
F	.075	.175	1.91	4.44	
G	---	.405	---	10.29	
H	.163	.189	4.15	4.80	2
J	.100	.140	2.54	3.56	
M	---	.350	---	8.89	Dia
N	.020	.065	.510	1.65	
P	.070	.100	1.78	2.54	Dia

D0203AA (D04)

- Available in JAN, JANTX and JANTXV
- MIL-PRF-19500/260
- Glass passivated die
- Glass to metal seal construction
- 240 Amps surge rating
- V_{RRM} to 1000 volts

Standard	Microsemi Catalog Number	Reverse	Peak Reverse Voltage
1N1202A	1N1202RA	1N1202RA	200V
1N1204A	1N1204RA	1N1204RA	400V
1N1206A	1N1206RA	1N1206RA	600V
1N3671A	1N3671RA	1N3671RA	800V
1N3673A	1N3673RA	1N3673RA	1000V

Electrical Characteristics

Average forward current	$I_{F(AV)}$ 12 Amps	$T_C = 150^\circ\text{C}$, half sine wave, $R_{\theta JC} = 2.0^\circ\text{C/W}$
Maximum surge current	I_{FSM} 240 Amps	8.3ms, half sine, $T_C = 200^\circ\text{C}$
Max I^2t for fusing	I^2t 240 A ² s	
Max peak forward voltage	V_{FM} 1.35 Volts	$I_{FM} = 38\text{A}; T_J = 25^\circ\text{C}^*$
Max peak reverse current	V_{FM} 2.30 Volts	$I_{FM} = 240\text{A}; T_J = 25^\circ\text{C}$
Max peak reverse current	I_{RM} 5 μA	$V_{RRM}, T_J = 25^\circ\text{C}$
Max peak reverse current	I_{RM} 1.0 mA	$V_{RRM}, T_J = 150^\circ\text{C}$
Max Recommended Operating Frequency	10kHz	

*Pulse test: Pulse width 300 μsec . Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temperature range	T_{STG}	-65°C to 200°C
Operating case temp range	T_C	-65°C to 150°C
Maximum thermal resistance	$R_{\theta JC}$	2.0°C/W Junction to Case
Mounting torque		15 inch pounds maximum
Weight		.16 ounces (5.0 grams) typical

11-27-00 Rev. 1

MILITARY

1N1202A-1N1206A, 1N3671A-1N3673A

Figure 1
Typical Forward Characteristics

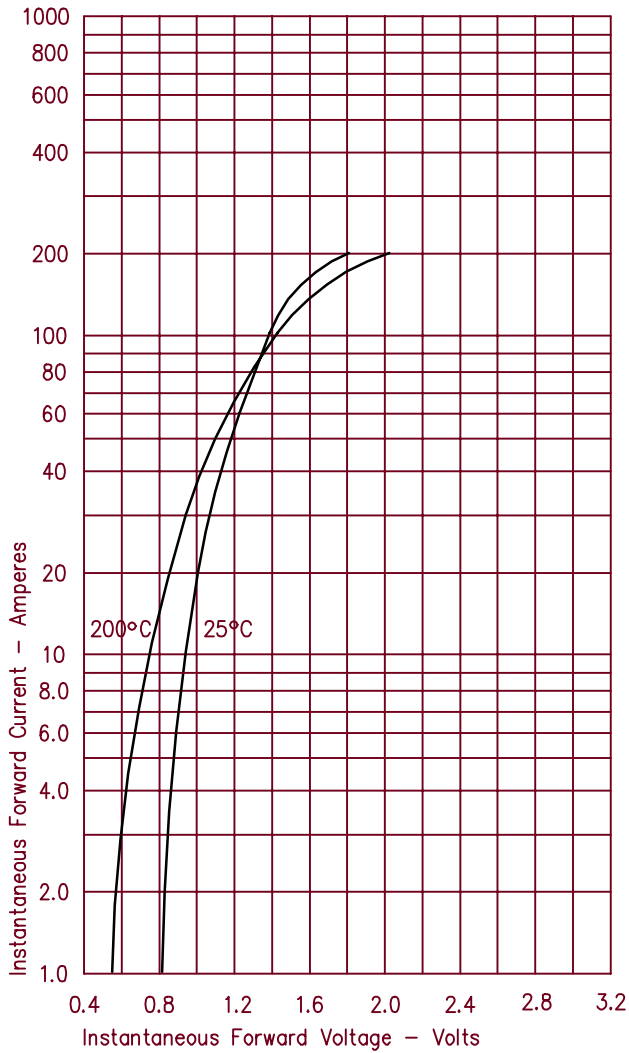


Figure 3
Forward Current Derating

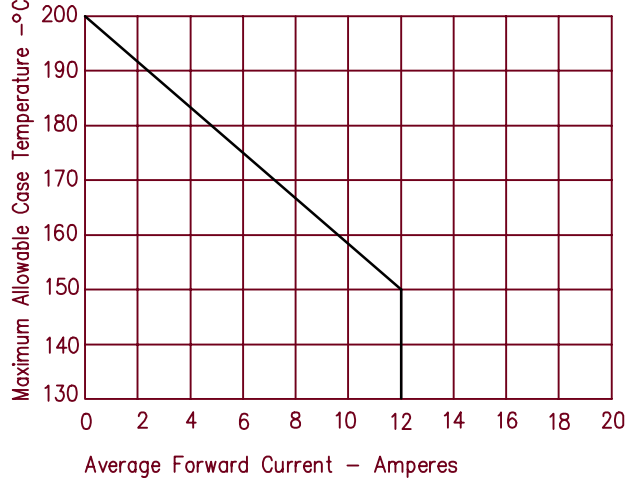


Figure 5
Transient Thermal Impedance

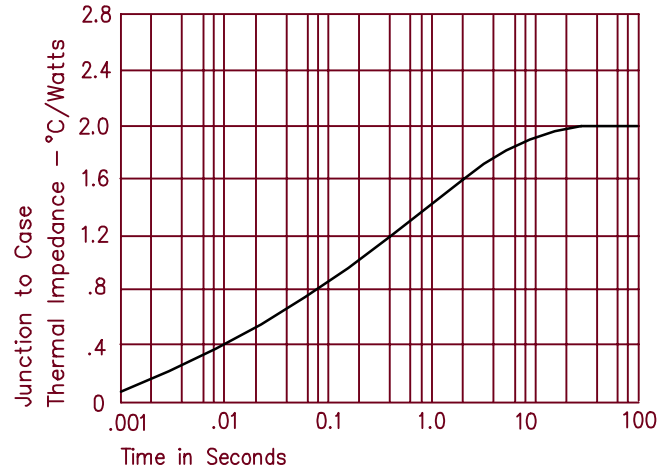
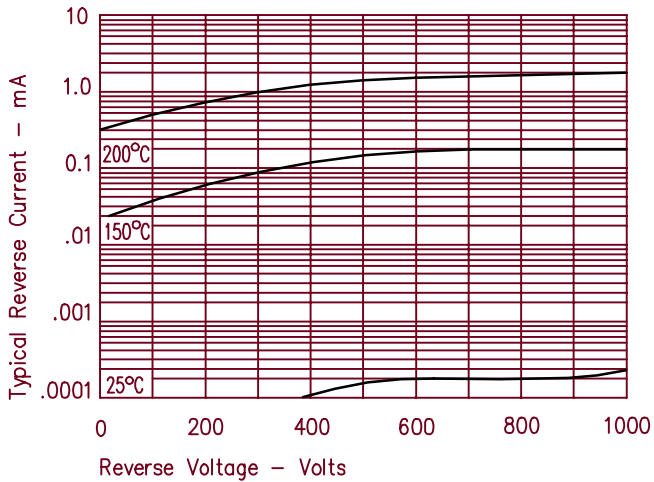


Figure 2
Typical Reverse Characteristics



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9